

Title (en)
Method to produce pn CdTe/CdS thin film solar cells.

Title (de)
Verfahren zur Herstellung von pn CdTe/CdS-Dünnschichtsolarzellen.

Title (fr)
Procédé pour fabriquer des cellules solaires à couches minces du type pn CdTe/CdS.

Publication
EP 0535522 A2 19930407 (DE)

Application
EP 92116254 A 19920923

Priority
DE 4132882 A 19911003

Abstract (en)
Method for producing pn-CdTe/CdS thin-film solar cells in which, on a transparent substrate in the form of inexpensive soda lime glass, a transparent TCO layer is deposited as a front contact, which layer is preferably provided with an ultra-thin indium layer which in turn is coated with the CdS layer, the substrate thus coated, up to the CdTe coating, being raised to a temperature between 480 DEG C and 520 DEG C, which is maintained during the subsequent rapid CdTe deposition according to the short-distance process using a preferred deposition rate from 5 to 15 $\mu\text{m}/\text{min}$ in an inert-gas atmosphere. The indium layer is dissolved during this deposition and produces the required n-doping of the CdS layer without an additional process step. In this manner it is possible to produce solar cells having a high efficiency in a cost-effective process suitable for mass production. <IMAGE>

Abstract (de)
Verfahren zur Herstellung von pn CdTe/CdS-Dünnschichtsolarzellen, in welchem auf einem transparenten Substrat in Form preiswerten Natron-Kalk-Glases eine transparente TCO-Schicht als Frontkontakt abgeschieden wird, die vorzugsweise mit einer ultradünnen Indiumschicht versehen wird, welche wiederum mit der CdS-schicht beschichtet wird, wobei das derart beschichtete Substrat bis zur CdTe-Beschichtung auf eine Temperatur zwischen 480 °C bis 520 °C gebracht wird, die während der folgenden schnellen CdTe-Abscheidung nach dem Kleindistanzverfahren mit einer vorzugsweisen Abscheidungsrate von 5 bis 15 $\mu\text{m}/\text{min}$ in einer Inertgasatmosphäre beibehalten wird. Die Indiumschicht löst sich während dieser Abscheidung auf und bewirkt die erforderliche n-Dotierung der CdS-Schicht ohne zusätzlichen Verfahrensschritt. Auf diese Weise können Solarzellen mit hohem Wirkungsgrad in einem kostengünstigen für die Massenfertigung geeigneten Verfahren hergestellt werden. <IMAGE>

IPC 1-7
H01L 31/0224; **H01L 31/072**; **H01L 31/18**

IPC 8 full level
H01L 31/0224 (2006.01); **H01L 31/04** (2006.01); **H01L 31/072** (2006.01); **H01L 31/073** (2012.01); **H01L 31/18** (2006.01)

CPC (source: EP US)
H01L 31/073 (2013.01 - EP US); **H01L 31/1828** (2013.01 - EP US); **Y02E 10/543** (2013.01 - EP US); **Y10S 438/967** (2013.01 - EP US)

Cited by
EP1041169A1; EP2454755A4; DE102008058530A1; WO2017134191A1; WO2011008254A1; US11217720B2

Designated contracting state (EPC)
BE CH DE ES FR GB IT LI

DOCDB simple family (publication)
EP 0535522 A2 19930407; **EP 0535522 A3 19930519**; **EP 0535522 B1 19961218**; DE 4132882 A1 19930429; DE 4132882 C2 19960509; DE 59207710 D1 19970130; ES 2097249 T3 19970401; HK 1007631 A1 19990416; JP 3221089 B2 20011022; JP H0645626 A 19940218; US 5304499 A 19940419

DOCDB simple family (application)
EP 92116254 A 19920923; DE 4132882 A 19911003; DE 59207710 T 19920923; ES 92116254 T 19920923; HK 98106147 A 19980623; JP 26461292 A 19921002; US 92951492 A 19920928